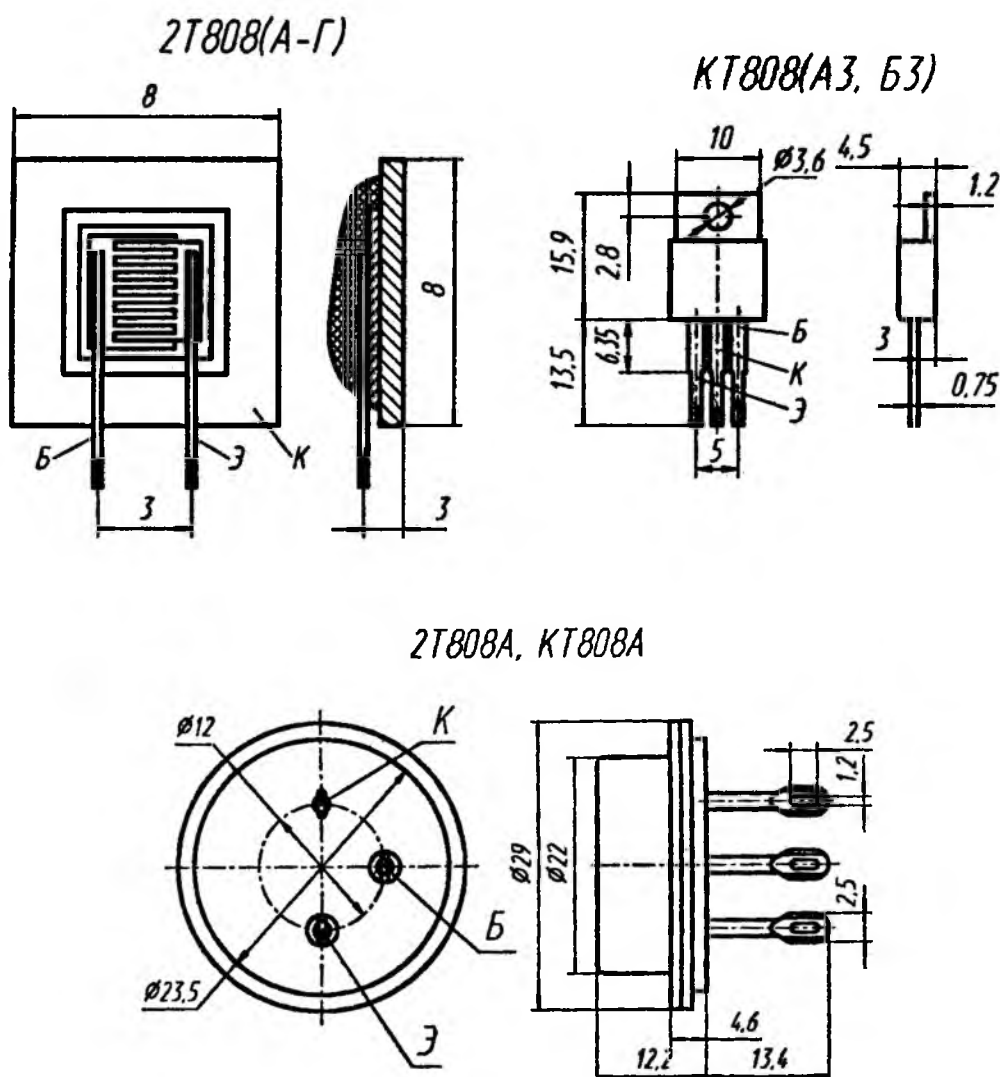


**2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808АМ, КТ808БМ,
КТ808ВМ, КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ**

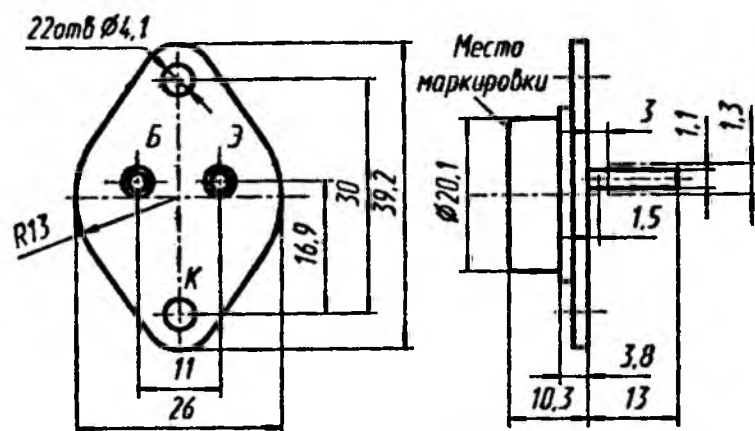
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Корпус транзисторов 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ—КТ808ГМ металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Транзистор 2Т808А-2 — бескорпусный на металлической молибденовой подложке с защитным покрытием и гибкими выводами, КТ808АЗ, КТ808БЗ — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Масса транзисторов 2Т808А, КТ808А (без накидного фланца) не более 22 г, КТ808АМ—КТ808ГМ — не более 20 г, 2Т808А-2 — не более 0,6 г, КТ808АЗ, КТ808БЗ — не более 2,5 г.

Изготовитель — завод «Искра», г. Ульяновск.



КТ808(АМ-ГМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А при $U_{кэ} = 3$ В,

$I_k = 6$ А:

$T = +25$ °С 10...15*...50

$T = +125$ °С для 2Т808А и $T = +100$ °С

для КТ808А 10...20*...150

$T = -60$ °С 6...10*...50

КТ808АМ-КТ808ГМ, КТ808А3, КТ808Б3

при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 2$ А 20...125

Модуль коэффициента передачи тока на вы-
сокой частоте $f = 3,5$ МГц при $U_{кэ} = 10$ В,

$I_b = 0,5$ А, не менее 2,4

Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А,

$L = 25$ мГн, не менее:

КТ808АМ, КТ808А3 130 В

КТ808БМ, КТ808Б3 100 В

КТ808ВМ 80 В

КТ808ГМ 70 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

КТ808АМ-КТ808ГМ при $I_k = 6$ А, $I_b = 0,6$ А,

не более 1,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер

при $I_k = 6$ А, $I_b = 0,6$ А 1*...1,4*...

2,5 В

Время рассасывания при $U_{кэ} = 15$ В, $I_k = 6$ А,

не более 2 мкс

Обратный ток коллектор-эмиттер

при $R_{бэ} = 10$ Ом, не более:

$T = +25$ и -60 °С и $U_{кэ} = 200$ В для

2Т808А, 2Т808А-2 и $U_{кэ} = 120$ В для

КТ808А 3 мА

$T = +125$ °С, $U_{кэ} = 160$ В для 2Т808А,

2Т808А-2 20 мА

$T = +100$ °С $U_{кэ} = 120$ В для КТ808А 50 мА

Обратный ток коллектора $I_{КЭ}$ 2Т808АМ—КТ808ГМ,
 КТ808АЗ, КТ808БЗ при $U_{КЭ} = U_{КЭ R, \text{МАКС}}$,
 $T = +25^\circ\text{C}$, не более 2 мА
 Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4\text{ В}$,
 не более 15 мА
 Емкость коллекторного перехода
 при $U_{КБ} = 10\text{ В}$, $f = 1\text{ МГц}$, не более 500 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер¹
 при $R_{БЭ} = 10\text{ Ом}$, $T_n \leq 100^\circ\text{C}$
 2Т808А, 2Т808А—2, КТ808А 120 В
 КТ808АМ, КТ808АЗ 130 В
 КТ808БМ, КТ808БЗ 100 В
 КТ808ВМ 80 В
 КТ808ГМ 70 В
 Импульсное напряжение коллектор—эмиттер¹
 при $t_n \leq 500\text{ мкс}$, $t_{\phi} \geq 30\text{ мкс}$, $U_{БЭ} = 2\text{ В}$ или
 $R_{БЭ} = 10\text{ Ом}$, $Q \geq 7$, $T_n \leq +100^\circ\text{C}$:
 2Т808А, 2Т808А—2, КТ808А, КТ808АМ 250 В
 КТ808БМ 160 В
 КТ808ВМ 135 В
 КТ808ГМ 80 В
 Постоянное напряжение эмиттер—база:
 2Т808А, 2Т808А—2, КТ808А 4 В
 КТ808АМ—КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ 5 В
 Постоянный ток коллектора 10 А
 Импульсный ток коллектора 15 А

¹ При $T_n = +100...150^\circ\text{C}$ постоянное и импульсное напряжение коллектор—эмиттер снижаются на 10% на каждые 10°C . Температура перехода рассчитывается по формуле

$$T_n = T_{\text{н}} + R_{T(n-K)}(P_K + P_3), ^\circ\text{C}.$$

Постоянный ток базы 4 А
 Постоянная рассеиваемая мощность коллек-
 тора при $T_K = -60...+50^\circ\text{C}$:
 с теплоотводом:
 2Т808А, 2Т808А—2, КТ808А 50 Вт
 КТ808АМ—КТ808ГМ, КТ808АЗ,
 КТ808БЗ 70 Вт
 без теплоотвода 2Т808А, КТ808А 5 Вт
 Тепловое сопротивление переход—корпус 2°C/Вт
 Температура p - n перехода $+150^\circ\text{C}$
 Температура окружающей среды:
 2Т808А, 2Т808А—2, КТ808АМ—КТ808ГМ ... $-60...T_K =$
 $= +125^\circ\text{C}$
 КТ808А, КТ808АЗ, КТ808БЗ $-60...T_K =$
 $= +100^\circ\text{C}$

Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора (от места выхода вывода из компаунда), температура пайки 2Т808А—2 не более $+250^\circ\text{C}$, 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ—КТ808ГМ не более $+275^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2Т808А—2 составляет 300 В.